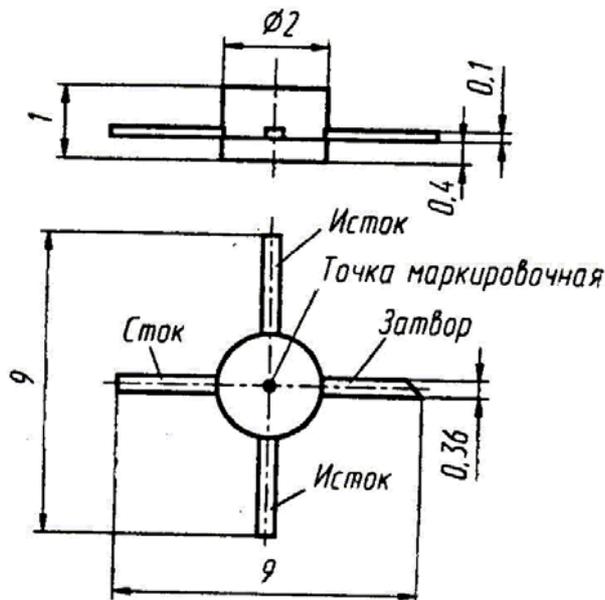


А802А, А802Б, А802В, А802Г, А802Д, А802Е, А802Ж

Транзисторы арсенидгаллиевые полевые с затвором в виде барьера Шотки и каналом n-типа усилительные с нормированным коэффициентом шума. Предназначены для применения в малошумящих усилителях на частотах до 12 ГГц в составе гибридных интегральных микросхем. Бескорпусные на кристаллодержателе с гибкими выводами. На транзисторы наносится условная маркировка точками: А802А — одна желтая, А802Б — одна синяя, А802В — одна зеленая, А802Г — одна черная, А802Д — две желтые, А802Е — две синие, А802Ж — две зеленые. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,05 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



Электрические параметры

Минимальный коэффициент шума при $U_{си} = 2,5$ В, $I_c = 10$ мА, не более:

А802А на $f = 12$ ГГц	1,5 дБ
А802Б на $f = 12$ ГГц	1,8 дБ
А802В на $f = 12$ ГГц	2 дБ
А802Г на $f = 12$ ГГц	2,5 дБ
А802Д на $f = 4$ ГГц	0,65 дБ
А802Е на $f = 4$ ГГц	0,8 дБ
А802Ж на $f = 4$ ГГц	1,2 дБ

Оптимальный коэффициент усиления по мощности при $U_{си} = 2,5$ В, $I_c = 10$ мА, не менее:

А802А, А802Б, А802В, А802Г на $f = 12$ ГГц	6 дБ
А802Д, А802Е, А802Ж на $f = 4$ ГГц	10 дБ

Крутизна характеристики при $U_{си} = 2,5$ В не менее 15 мА/В

Ток утечки затвора при $U_{зи} = -2,5$ В не более 100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток—исток	4 В
Постоянное напряжение затвор—исток	3 В
Потенциал статического электричества	30 В
Постоянная рассеиваемая мощность ¹ при $T = -60...+40$ °С	80 мВт
Температура окружающей среды	—60...+125 °С

1. При $T > +40$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность снижается линейно до 15 мВт при +125 °С.

Минимальное расстояние от кристаллодержателя до места пайки, сварки вывода не менее 1,5 мм. Допускается пайка, сварка на расстоянии 1 мм от кристаллодержателя. Температура пайки не выше +260 °С, время не более 3 с.

Допускается однократный изгиб выводов на расстоянии 1 мм от кристаллодержателя.

Разрешается использование транзисторов А802Д, А802Е, А802Ж в диапазоне частот 3,6...4,2 ГГц.

При эксплуатации транзисторов в усилительных схемах следует учитывать возможность их самовозбуждения как высокочастотных элементов и принимать меры к его устранению.